# دراسة طيفية لوصلات لا متجانسة تصدر اللون الأبيض تتكون من(FTO/ZnS/CdSe(MPA

**الدكتور قيصر صلاح اليماني** مدرس في قسم الفيزياء كلية العلوم- جامعة الفرات **الملخص** 

تم تحضير منظومة وصلات لامتجانسة نانوية البنية من أنصاف النواقل تتكون (البخ الحراري المحلول FTO/ZnS/CdSe (MPA) باستخدام تقنيات مختلفة (البخ الحراري المحلول الغروي). دُرست الخصائص الضوئية لهذه المنظومة على مرحلتين:

أولاً دراسة طيف الامتصاص الضوئي لهذه المنظومة حيث تم حساب طاقة الانتقالات الطيفية واقتراح السويات الطاقية و الاطوال الموجية الموافقة من خلال تحليل طيف الامتصاص الضوئي باستخدام الشكل الدوبلري لتعريض الخط الطيفي وباستخدام برنامج Mathcade ، كذلك حسبت قيمة المهتز الكوانتي الموافق لكل انتقال طيفي، زمن الحياة للحالة المثارة و ثوابت أينشتاين في الإصدار والامتصاص التلقائي الموافقة لهذه الانتقالات. و أخيرا دُرست تغيرات زمن حياة الاكسيتونات المتشكلة مع تغير طول موجة الامتصاص.

ثانياً : من خلال دراسة طيف الفلورة الضوئية حيث أظهر طيف الفلورة لهذه المنظومة ستة قمم فلورة ضوئية تغطي كامل منطقة الطيف المرئي من الطيف الكهرطيسي وحسب قاعدة مزج الألوان فإن هذه المنظومة سوف تعطي اللون الأبيض، تم تحليل طيف الفلورة الضوئية باستخدام برنامج Mathcade وتم تحديد الانتقالات الالكترونية الموافقة مع حساب طاقتها وقيمة المهتز الكوانتي الموافق لها. الكلمات المفتاحية: طيف الفلورة ،نقاط كوانتية ، سيلينيوم كادميوم، كبريتيد الزنك،

#### 1-مقدمة:

يعتبر نصف الناقل سيلينوم – كادميوم (CdSe) من أهم أنصاف النواقل للمجموعتين الثانية والسادس في الجدول الدوري[Q. Lu..et al.,2006]،حيث يمتلك خصائص فريدة جعلته محط اهتمام الكثير من الباحثين في العالم لإمكانية استخدامه في تطبيقات فيزيائية مختلفة [2010] Y. Wang..et al., إو من أهم الخصائص التي يبديها إمكانية تغير نصف قطره بنتيجة اختلاف درجة التقييد الكوانتي الذي يخضع له ضمن البني المحضرة وبالتالي تغير طول موجة الامتصاص و الإصدار الموافقة له باختلاف درجة التقيد الكوانتي [N. Dipesh., 2012]، حيث أن المادة الأساسية. (Bulk Material) منه تمتلك عرض مجال محظور يوافق القيمة 1.74ev تقابل طول موجة امتصاص 712.6nm أي تقع في منطقة الأحمر القريب ضمن المجال الكهرطيسي [K. Cat Cuong et al.2009]. إن وضع نصف الناقل هذا في منظومة تقيد كوانتي من النوع الأول تؤدي إلى زبادة عرض المجال المحظور له. وبالتالي تناقص نصف قطر النقاط الكوانتية المتشكلة منه مما يؤدى إلى تغير في طول موجة الإصدار والامتصاص وذلك بحسب علاقة Brus المبنى على تقريب السوبات القطعية للطاقة، مما يجعله هدف لتعيينه كمادة فعالة في متصلات الانبعاث الضوئية متعددة الطبقات التي تصدر اللون الأبيض وكذلك في الخلايا الشمسية متعددة الطبقات لأنه يمتص ويصدر أطوال موجية تغطى كامل الطيف المرئي .S] .Herman, et al .2011]

## 2- أهداف البحث :

في هذا البحث تم تحضير نقاط كوانتية من (CdSe(MPA ودراسة أثر التقيد الكوانتي في هذا النوع من المتصلات من خلال طيوف الامتصاص و الفلورة حيث تم تحضير عدة بنى من المتصلات للذرات الصنعية CdSe QDs ضمن النموذج الأول للتقيد الكوانتي أي أن الفجوة الطاقية للذرة الصنعية CdSe QDs تقع ضمن الفجوة

الطاقية لباقي طبقات المتصل لضمان حدوث ظاهر انقلاب إسكاني وبالتالي إصدار فلورة تعطى اللون الأبيض لهذه المتصلات.

#### 3- مواد وطرائق البحث:

1-3- المواد الكيميائية المستخدمة

ماء مقطر –مسحوق معدن السيلينوم Se – هيدرازين – أيتلين غليكول – نترات الفضة– شرائح زجاجية ،اسيتات الزنك ،كلوريد الكادميوم ، كرومات البوتاسيوم ،حمض الفلور ، كلوريد القصدير ، دي إيتيل أمين،ايزوبروبيل الكحول، الايثانول،كبريتيت الصوديوم.

2-3- تحضير الوصلات اللامتجانسة:

## n -1−2−3 تحضير طبقةFTO من النوع n:

أخذت مجموعة من الشرائح الزجاجية ونظفت باستخدام كرومات البوتاسيوم لمدة ساعتين ثم وضعت في حمض الفلور الممدد لمدة عشر دقائق لتخرش السطح الخارجي للشرائح ثم جففت و وضعت على سخان كهربائي لرفع درجة حرارة السطح الخارجي حتى الوصول للدرجة 5000. تم حل 5gr من كلوريد القصدير في 20ml من ايزوبروبيل الكحول مع إضافة بضع قطرات من حمض الفلور إلى المحلول، رسب المحلول على الشريحة الزجاجية باستخدام تقنية البخ ثم قيست المعلول، رسب المحلول على الشريحة الزجاجية فوجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية فوجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية فوجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية فوجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية موجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية موجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية موجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية ورجد أن مقاومة الفلم المرسب من المقاومة الكهربائية السطحية للشرائح الزجاجية وراحية وراحين من عروم النوع N.

## ZnS تحضير محلول من ZnS

حُل 0.1mol من اسيتات الزنك في 100ml من الإيثانول تم إضافة لهذا المزيج 0.1mol من كبريتيت الصوديوم مع التحريك المستمر على خلاط مغناطيسي مع التسخين حتى الدرجة 50C . يتشكل بنهاية التفاعل محلول معلق من كبريت الزنك رسبت طبقة من كبريت الزنك بطريقة السبين على شريحة FTO ثم لدنت الشريحة الزجاجية عند الدرجة 450C°.

## CdSe (MPA) المشابة بالفضة: -2−3 تحضير المنظومة (CdSe (MPA) المشابة بالفضة:

تم حل 0.1mol من اسيتات الكادميوم في 100ml من الماء المقطر باستخدام خلاط مغناطيسي، أضيف إلى المحلول السابق 0.1mol من ميتابرابونك أسيد مع التحريك المستمر حتى تمام الانحلال ليتشكل محلول ابيض حليبي نسميه المحلول (A). نأخذ nol من السيلنيوم ويوضع في 100ml من الماء المقطر يضاف إلى المزيج السابق 25ml من السيلنيوم ويوضع في الما00 من الماء المقطر زجاجية وتركب على دورة تبريد مرتد عند الدرجة 300 لمدة 6 ساعات يضاف إليها زجاجية وتركب على دورة تبريد مرتد عند الدرجة 200 لمدة 6 ساعات يضاف إليها احمر خمري red wine نسميه المحلول السابق بنهاية التفاعل يتشكل محلول نسبة 3/1 من المحلول الأول إلى المحلول الثاني فيتشكل محلول اصفر اللون يتحول لونه للون الأبيض مع زيادة الزمن نتيجة زيادة حجم العنقود الذري المتشكل .[B.J]

[0.01mol/L إلى المحلول السابق مع التحريك المستمر باستخدام خلاط 0.01mol/L إلى المحلول السابق مع التحريك المستمر باستخدام خلاط مغناطيسي، وتم ترسيب المحلول على شرائح زجاجية شفافة ناقلة للتيار الكهربائي(FTO) من النوع n من بهدف دراسة الخصائص الضوئية لهذه الأقطاب بهدف تطبيقها في صناعة الخلايا الشمسية ومتصلات الانبعاث الضوئية السبين فوق طبقة (J. Tian... ترسيب طبقة من كبريتيد الزنك ZnS بطريقة السبين فوق طبقة الصنعية (Dece) و لدنت حتى الدرجة 500 باستخدام مرمدة كهربائية، رسبت طبقة من الدرات

### 4- النتائج والمناقشة:

FTO/ZnS/CdSe(MPA) الضوئى للمنظومة (FTO/ZnS/CdSe(MPA)

أخذ طيف الامتصاص الضوئي باستخدام مطياف الأشعة الضوئية المرئية وفوق البنفسجية ضمن مجال من الأطوال الموجية (200m–900). يبين الشكل (1) طيف الامتصاص المأخوذ عند درجة حرارة الغرفة حيث يظهر الطيف وجود أربع قمم امتصاص اكسيتونية (تسمى الانتقالات الالكترونية في النقاط الكوانتية بالانتقالات الاكسيتونية ) واضحة موافقة للأطوال الموجية (200m–650-650-400)تطابق الاطوال الموجية للألوان الأحمر، الأخضر والأزرق وتوافق الطاقات على الترتيب الاطوال الموجية للمناقات الالكترونية (200m) ويبين الشكل المواقة خمان الالكترونية الماتوات الالكترونية الموافقة ضمن بنية المنظومة.



الشكل (2) الانتقالات الالكترونية الممكنة ضمن بنية المنظومة.

والجدول (1) يبين قيم الاطوال الموجية الموافقة لقمم الامتصاص والانتقالات الإلكترونية المحتملة وطاقاتها الموافقة بواحدة eV .

القمة	طول موجة	طاقة الانتقال	الانتقالات الالكترونية الموافقة على المخطط
	الامتصاص	(e V) الطيفي	
	nm		
(1)	850	1.458	a-e $Trap(CdSe) \rightarrow Trap(ZnS)$
(2)	650	1.907	a-d $VB(CdSe) \rightarrow CB(ZnS)$
(3)	465	2.666	c-b $VB(ZnS) \rightarrow CB(CdSe)$
(4)	400	3.100	c-e $VB(ZnS) \rightarrow Trap(ZnS)$
(5)	538	3.263	a-e $VB(CdSe) \rightarrow Trap(ZnS)$

والجدول (1) يبين الانتقالات الالكترونية وطاقة الانتقالات ضمن الوصلات اللامتجانسة.

2-4- تحليل طيف الامتصاص الضوئي وتحديد الانتقالات الالكترونية

#### FTO/ZnS/CdSe(MPA)よ

بهدف تحديد الانتقالات الإلكترونية الموجودة ضمن طيف الامتصاص الضوئي للمنظومة (FTO/ZnS/CdSe(MPA، تم أجراء التحليل الطيفي لطيف الامتصاص الضوئي باستخدام الشكل الغوصي لتعريض الخط الطيفي بالاعتماد على برنامج Mathcad، حيث تم إدخال قيم المتحولات للتابع الغوصي المعطى بالعلاقة التالية[.P.R.Bueno etal.,2000]:

Gaussian(x,a) = 
$$\sum_{n=0}^{m} a_{mn+1} \exp \left[-\left(\frac{a_{mn+2}-x_i}{a_{mn+3}}\right)^2\right]$$

حيث m العدد الكلي للتوابع الغوصية التي ستدخل ضمن عملية الموائمة (fitting) وهي تشير الى عدد الحزم الطيفية الثانوية حيث m....,a<sub>mn+1</sub> ، n=0,1,2,....mيشير الى قيمة معامل الامتصاص الضوئي المرتبط بطول الموجة، <sub>2+m</sub>هيمثل طول موجة الحزمة الطيفية ، <sub>3+m</sub>عرض الشدة عند المنتصف لارتفاع الحزمة الطيفية، x<sub>i</sub> عدد الأطوال الموجية المقاسة لكامل الطيف.تم إدخال القيم النظرية للانتقالات الإلكترونية الموجودة ضمن هذه المنظومة وإجراء عملية التكامل التفافي ( Convolution ) بين القيم النظرية للانتقالات الإلكترونية مع طيف الامتصاص التجريبي كما يوضح الشكل (3).



الشكل (3) تحليل طيف الامتصاص بالاعتماد على برنامج Mathcad. تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج Mathcad وذلك عن طريق مطابقة الانتقالات الإلكترونية النظرية مع الانتقالات الإلكترونية في الطيف التجريبي للحصول على أفضل تطابق ومن ثم رسمها. تم استخدام الشكل الغوصي لتعريض الخط الطيفي حيث تم تقسيم طيف الامتصاص أثناء المعالجة إلى سبع عصب متصاص تغطي كامل طيف الامتصاص التجريبي. يبين الشكل (4) موائمة طيف الامتصاص التجريبي حيث يلاحظ وجود عصب طيفية عريضة ناتجة عن الطيوف الالكترونية و الاهتزازية والدورانية وعلى الاغلب الإلكترونية ويمثل مركز العصبة الانتقال الإلكتروني الموافق لكل عصبة طيفية تم إيجادها باستخدام الشكل الغوصي لتعريض الخط الطيفي.



الشكل (4) الانتقالات الإلكترونية الناتجة عن موائمة طيف الامتصاص الضوئي التجريبي مع الانتقالات النظرية

إن قمم الامتصاص الموجودة عند الأطوال الموجية-628-410-449 التي تم الحصول عليها باستخدام التحليل الغوصي كانت قريبة من الانتقالات النظرية الموجودة ضمن الذرات الصنعية ZnS التي تتضمن الانتقالات من عصابة التكافؤ إلى فراغات عصابة التكافؤ إلى فراغات الزبك ضمن البنية وكذلك الانتقالات الناتجة عن الفجوة الطاقة المباشرة كما يبين المخطط الطاقي لبنية هذه الذرات الممثل بالشكل (5) [ X. Wang..etal., 2011].



الشكل (5) الانتقالات الإلكترونية ضمن ZnS.

وباستخدام العلاقة التي تربط بين المقطع العرضي للامتصاص الضوئي مع قوة الاهتزاز الكوانتي للحالات المثارة تم حساب قوة الاهتزاز لقمم الامتصاص الخمس الأولى بالاعتماد على العلاقة [P. Yu, et al., 2005]:

$$f = \frac{4.m.\varepsilon_0.c}{e^2} \int \sigma(v) \, dv$$

حيث o تمثل المقطع العرضي للامتصاص الضوئي، mكتلة الإلكترون، o سرعة الضوء، e شحنة الالكترون ،<sub>0</sub>3 سماحية الخلاء. إن قيمة قوة الاهتزاز منسجمة مع الانتقالات الالكترونية المتعددة للإلكترون والملاحظة في قيم طيف الامتصاص و بمعرفة قيمة قوة الاهتزاز يمكن حساب معامل أينشتاين B<sub>12</sub> والذي يرتبط بقوة الاهتزاز بالعلاقة [J. R. Albani, 2007]:

$$f = \frac{mh\upsilon}{\pi e^2} B_{12} \implies B_{12} = \frac{\pi e^2 f}{mh\upsilon}$$

حيث U تردد الموجة الموافقة لقمة العصبة الناتجة عن التحليل الغوصي لطيف الامتصاص ، *h* ثابت بلانك ، *m* كتلة الالكترون ، *b* شحنة الالكترون . وبالاعتماد على العلاقة التي تربط بين معاملات اينشتاين للامتصاص والإصدار يمكن حساب معامل الإصدار التلقائيA<sub>21</sub> =  $\frac{8\pi hv^3}{c^3}B_{12}$  [J.I .Gersten., 2005] A<sub>21</sub> =  $A_{21}$ كما يمكن حساب عزم ثنائي القطب الضوئي D والذي يرتبط بمعامل أينشتاين للإصدار التلقائيA<sub>21</sub> بالعلاقة التالية[S. A. Crooker...etal.,2002] :

$$A_{21} = \frac{32\pi^{3}\nu^{3}}{3C^{3}\eta}D \implies D = \frac{A_{21}3C^{3}\eta}{32\pi^{3}\nu^{3}}$$

وكذلك يمكن حساب زمن حياة الانتقال المشع في الحالة المثارة بالاعتماد على معامل الينشتاين للإصدار التلقائي  $A_{21}$  والذي يعطى بالعلاقة [M. Brandt,2010]: $A_{21} = \frac{1}{t}$ 

والجدول (2) يلخص النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام العلاقات السابقة بعد الاستفادة من قيم معامل الامتصاص في طيف الامتصاص الضوئي.

الاهتزاز	مركز	عرض	$\nu \times 10^{14} H_{7}$	f	$B_{12*}10^{23}$	$A_{21*10}^{+10}$	D*10 <sup>-45</sup>	t(sec)
	العصبة	العصبة			(1/S)	(1/S)	m <sup>3</sup> J	
	nm	nm						
1	817	123	3.67	2.01	6.57	2	3.4	4.98E-11
2	628	109	4.77	2.38	5.98	4.02	3.1	2.48E-11
3	511	62	58.7	3.90	7.98	9.95	4.2	1.00E-11
4	449	34	6.68	0.14	0.25	0.46	0.13	2.16E-10
5	410	19	7.31	0.12	0.19	0.47	0.10	2.10E-10

الجدول (2) حساب معاملات اينشتاين للإصدار التلقائي.

4-3- دراسة تغيرات زمن حياة الاكسيتون مع طول موجة الامتصاص:

برسم تغيرات زمن حياة الاكسيتون المتشكل (ثنائي القطب الضوئي) عند كل قمة للامتصاص الضوئي كتابع لطول موجة الامتصاص كما يبين الشكل (6)، لاحظ أن زمن الحياة للاكسيتونات المتشكلة عند الاطوال الموجية القصيرة 400 nm(الاكسيتونات المتشكلة عند تداخل طبقة FTO/ZnS) يكون كبير وهذا ناتج عن تداخل الفجوات الطاقية في البنية المتشكلة للمنظومة ويتناقص هذا الزمن مع ازدياد طول موجة الامتصاص حتى يصل للطول الموجي 510nm حيث يبدأ بالزيادة مع ازدياد طول موجة الامتصاص (الاكسيتونات المتشكلة ضمن الذرات الصنعية والامتصاص إلامتصاص الامتفالات الالكترونية المرافقة لعملية الإصدار والامتصاص إلامتصاص [S. A Crooker, eta. 2002].



الشكل (6) تغيرات زمن حياة الاكسيتون مع طول موجة الامتصاص الضوئى.

FTO/ZnS/CdSe(MPA) للمنظومة (FTO/ZnS/CdSe(MPA) تم قياس طيف الفلورة الضوئية للمنظومة باستخدام مطياف الفلورة الضوئية تم قياس طيف الفلورة الضوئية لهذه المنظومة باستخدام مطياف الفلورة الضوئية لهذه المنظومة باستخدام مطياف الفلورة الضوئية لهذه المنظومة موجة إثارة 250nm . يظهر الشكل (7) طيف الفلورة الضوئية لهذه المنظومة حيث يظهر وجود أربع قمم فلورة عند أطوال موجية مختلفة متفاوتة في الشدة وهذا ناجم عن فلورة الطبقات التي تتألف منها هذه المنظومة.



الشكل (7) طيف الفلورة الضوئية للمنظومة STO/ZnS/CdSe(MPA) Core Shell ويلاحظ من تعود قمة الفلورة الأولى عند الطول الموجي 325nm لفلورة طبقة FTO ويلاحظ من هذه القمة أنها حادة وذات شدة عالية بالنسبة لبقية قمم الفلورة وهذا ناتج عن انتقال أحادي مباشر ضمن عرض المجال المحظور لطبقة FTO . تعود قمة الفلورة الثانية أحادي مباشر ضمن عرض المجال المحظور لطبقة TO . تعود قمة الفلورة الثانية عند الطول الموجي والتي تتمركز عند الطول الموجي 500 . ولاحظ من عند الطول الموجي مباشر ضمن عرض المجال المحظور لطبقة TO . تعود قمة الفلورة الثانية أحادي مباشر ضمن عرض المجال المحظور لطبقة TO . تعود قمة الفلورة الثانية عند الطول الموجي والتي تتمركز عند الطول الموجي مي فلورة كبريتيد الزنك حيث يلاحظ أن هذا العرض في طيف الفلورة ناتج عن كثافة في الانتقالات الالكترونية ضمن المجال المحظور لحرال الموجي المحظور الموجي الموجي من المجال المحظور الموجي الانتقالات الالكترونية ضمن المجال المحظور الموجي المحظور الموجي المحظور الموجي من الموجي من المجال المحظور الموجي عن فلورة كبريتيد الزنك حيث يلاحظ أن هذا العرض في طيف الفلورة ناتج عن كثافة في الانتقالات الالكترونية ضمن المجال المحظور المحظور الموجي المحظور الموجي المول الموجي المحظور الموجي من فلورة كبريتيد الزنك حيث يلاحظ أن هذا العرض في طيف الفلورة ناتج عن كثافة في الانتقالات الالكترونية ضمن المجال المحظور المحظور لـ CdSe, ZnS وهي منزاحة نحو المحظور الموجية الأقصر نتيجة التقيد الكوانتي الحاصل ضمن هذه البنية

[2012] V. Perumal .etal.,2012]. في حين أن قمة الفلورة الموجودة عند الطول الموجي 500nm عائدة للذرات الصنعية CdSe(MPA)core shellالمغلفة بمادة ميتابرابونك اسيد ويلاحظ أن هذه القمة متناظرة نتيجة فلورة الذرات الصنعية CdSe المقيدة كوانتياً بمادة MPA كما يلاحظ وجود قمة فلورة ضعيفة الشدة وعريضة وغير متناظرة ناتجة عن فلورة الذرات الصنعية لCdSe المقيدة كوانتياً بشكل جزئي وكذلك ناتجة عن الانتقالات الاهتزازية و الدورانية الموجودة ضمن الذرات الصنعية

وأخيراً تشكل ذرات صنعية ذات احجام مختلفة والجدول (3) يبين قمم الفلورة الضوئية والطاقات الموافقة.

Ν	λ(nm)	E <sub>g</sub> (ev)
1	340	3.64
2	400	3.10
3	430	2.88
4	500	2.48
5	565	2.14
6	610	2.02

الجدول (3) الأطوال الموجية للفلورة الضوئية وطاقاتها الموافقة

إن انزياح قمة الفلورة للذرات الصنعية المغلفة بمادة MPA عن الذرات الصنعية CdSe ناتج عن التقيد الكوانتي وهذا يتطابق مع طيف الامتصاص الضوئي لهذه المنظومة، إن الانتقالات الالكترونية الحاصلة ضمن الذرات الصنعية هي انتقالات ستوكسية معاكسة وهذا يظهر بمقارنة طيف الفلورة الضوئية مع طيف الامتصاص الضوئي لهذه المنظومة.

4-5- موائمة طيف الفلورة باستخدام الشكل الغوصي لتعريض الخط الطيفي: لا يمكن تحديد الانتقالات الالكترونية بين السويات الالكترونية المختلفة بدقة بسبب العرض الكبير لقمم الفلورة الناتجة عن الانتقالات الاهتزازية و الدورانية والالكترونية وكذلك التعريض التصادمي الناتج الاثارة الضوئية (الأساسية والمثارة). وبإجراء موائمة بين طيف الفلورة التجريبي و طيف الفلورة النظري مع فرض أن جميع أشكال الخطوط الطيفية الناتجة عن الانتقالات الالكترونية من الشكل الغوصي وبإجراء فك الارتباط (DE convolution) مع استخدام الشكل الغوصي لتعريض الخط الطيفي ضمن الأطوال الموجية من المالكتروني ،بافتراض وجود سبع عصب طيفية ،حيث يمثل مركز كل عصبة الانتقال الالكتروني الرئيسي والذي يتطابق إلى حد كبير مع الانتقالات النظرية الموجودة ضمن هذه البنية كما يبين الشكل (8).



الشكل (8) طيف الفلورة الضوئي التجريبي(E)والانتقالات النظرية (T) الموجودة ضمن هذه البنية. تمت معالجة البيانات للانتقالات النظرية مع طيف الفلورة التجريبي باستخدام برنامج Mathcad ليعطي أفضل موائمة بين الطيف التجريبي العملي والطيف النظري حيث تم الحصول على سبع عصب طيفية ذات قمم متمركزة عند الأطوال الموجية (9).



الشكل (9) موائمة بين طيف الفلورة التجريبي والطيف النظري لتعريض الغط الطيفي. يلاحظ من طيف الفلورة التجريبي تفاوت في عرض قمم الفلورة المتشكلة عند إثارة هذه المنظومة ويفسر هذا الاختلاف بتشكل حجوم مختلفة من العناقيد الذرية في طبقات هذه المنظومة بالإضافة للتعريض الناتج عن الطيوف الاهتزازية و الدورانية ،التعريض التعريض التصادمي الناتج عن تفاعل الفوتون مع طبقات المنظومة ،إضافة لاسترخاء الإلكترونات المثارة من عدة سويات إلى سويات مختلفة محققة قواعد الاصطفاء المشع المتقروم الذرية وينتج عن تفاعل الفوتون مع طبقات المنظومة ،إضافة لاسترخاء الإلكترونات المثارة من عدة سويات إلى سويات مختلفة محققة قواعد الاصطفاء المشع المتقاربة من بعضها البعض ضمن هذه المنظومة مما يؤدي الى إتساع في عرض قمة الفلورة وهذا يبدو واضحاً عند قمة الفلورة الضوئية الموافقة للطول الموجي قمة الفلورة وهذا يبدو واضحاً عند قمة الفلورة الضوئية الموافقة للطول الموجي مع عرض مع عصب الفلورة الخارات الصنعية CdSe(MPA) Core Shell مع عصب الفلورة الغارات الصنعية الموافقة الطول الموجي مع Shell مع عصب الفلورة الغائدة للذرات الصنعية المات الموابية موافعة الإضاءة الفلورة الغائرة إلى تداخل عصب الفلورة الضوئية المول الموجي مع ما يؤدي الى معائدة الموت الموجي تحم مع مع مع مع مع مع من هذه المنظومة مع يؤدي الى إتساع في عرض مع ما يؤد وهذا يبدو واضحاً عند قمة الفلورة الضوئية المول الموجي تحم مع من الموج وهذا يبدو واضحاً عند قمة الفلورة الضوئية الموافقة للطول الموجي مع ما يؤدة الفرات الصنعية الفلورة الضوئية المولوا الموجي مع مع مع مع المورة الذرات الصنعية المورة الزرات الموجي مع مع مع الفلورة الفرية الذرات الصنعية المتواجدة ضمن السويات القابلة للفلورة لهذه القم فهو عائد لكثافة الذرات الصنعية المتواجدة ضمن السويات القابلة للفلورة فمثلاً الشدة المرتفعة للفلورة عند الطول الموجى مع مع المول الموجي مع مع الهذه القم فهو عائد لكثافة الذرات الصنعية المتواجدة ضمن السويات القابلة للفلورة فمثلاً الشدة المرتفعة للفلورة عند الطول الموجى مع مع المول الموجى مع مع المول الموج مع مع المول الموجى مع مع مي المور عند الطول الموجى مع مع مع مع مع مع الفلورة المول الموجى مع مع مي مع مي مع من المول الموجى مع المول الموجى مع المول الموجى مع الذرات الصنعية في هذه المنظومة تتفلور عند هذا الطول الموجي. إن وجود قمم فلورة ضوئية عند أطوال موجية مختلفة توافق الألوان الأزرق والأصفر والأحمر وحسب قاعدة مزج الألوان (احمر +اصفر +ازرق = اللون الأبيض) ينتج لدينا اللون الأبيض. كما تم حساب قوة الاهتزاز الكوانتي لكل قمة من قمم الفلورة السابقة والذي يمثل احتمال حصول الفلورة على هذه القمة باستخدام العلاقة التالية [P. Yu, et] احتمال حصول الفلورة على هذه القمة باستخدام العلاقة التالية الالور]

$$f = \frac{4.m.\varepsilon_0.c}{e^2} \int \sigma(v) dv$$

حيث o تمثل المقطع العرضي للامتصاص الضوئي، mكتلة الإلكترون، c سرعة الضوء، e شحنة الالكترون ، c سماحية الخلاء. يلاحظ من الجدول (4) أن شدة الفلورة الضوئية ضعيفة عند الطول الموجي 632.48nm مع احتمالية كبيرة لقوة الاهتزاز وهذا يمكن تفسيره أن العرض عند منتصف الشدة لهذه القمم كبير وإن الشدة الفلورة متناسبة مع المساحة تحت المنحني وفي حالة الطول الموجي 632.48nm فإن المساحة المحصورة تحت هذه القمة أكبر من باقي قمم الفلورة الضوئية مما يوافق قوة الاهتزاز الكوانتي مرتفعة.

n	λ(nm)	E(e v	f
1	307.4	4.03	3.123×10 <sup>-5</sup>
2	338.6	3.66	1.542×10 <sup>-4</sup>
3	398	3.11	3.309×10 <sup>-4</sup>
4	500	2.48	1.013×10 <sup>-4</sup>
5	557	2.22	6.243×10 <sup>-4</sup>
6	632.48	1.96	1.585×10 <sup>-3</sup>

والجدول (4) يبين قيم قوة الاهتزاز الكوانتي الموافق لكل قمة فلورة ضوئية.

5- الاستنتاجات والتوصيات:

تم تحضير وصلات لا متجانسة متعددة الطبقات من FTO/ZnS/CdSe(MPA) درست الخصائص الضوئية لهذه المنظومة، اظهر طيف الامتصاص الضوئي وجود عدة انتقالات امتصاص اكسيتونية تغطى كامل طيف

المرئي، تم أجراء تحليل طيف الامتصاص الضوئي ومعرفة الانتقالات الاكسيتونية مع طاقاتها الموافقة. أظهر طيف الفلورة الضوئية وجودة عدة قمم إصدار تغطي مناطق اللون الأحمر، الأخضر والأزرق وبحسب قاعدة مزج الألوان فان الضوء الذي تصدره هذه المنظومة هو اللون الأبيض. نوصي باستخدام هذه المنظومة كمادة فعالة في صناعة متصلات الانبعاث الضوئي متعدد الطبقات لإصدار اللون الأبيض.

#### **Reference:**

B.J. LeRoy, J. Kong, V.K. Palhiwani, C. Dekker, S.G. Lemay, Individual single-walled carbon nanotubes as nanoelectrodes for electrochemistry. Phys. Rev. B72, 075413 (2005).

J. R. Albani "**Principles and Applications of Fluorescence Spectroscopy**". ISBN 978-1-40513891-8,2007.

J.IGersten, "**Theory of fluorophore-metallic surface interactions, in Topics in Fluorescence Spectroscopy**", Vol. 8:197- 221. (2005).

J.M.Caruge , J.E.Halpert "**Colloidal Quantum-Dot Light-Emitting Diodes with metal –oxide charge transport layers** "journal of Natural Photonics Vol2, April 2008.

J Tian,Xuanhui Qu,Qifeng Zhang,Shengen Zhang,Evan Uchaker , Zhiqiang Liang,and Guoz,hong Cao Rui Gao" Constructing ZnO nanorod array photoelectrodes for highly efficient quantum dot sensitized solar cells" J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 6770

K. Cat Cuong, T. Duc Thien, "Sol-Gel Synthesis And Particle Size Characterization Of CdSe(MPA) Quantum Dots". Vnu Journal Of Science, Mathematics - Physics 25 (2009) 207-211.

M. Brandt "Introduction to Spectroscopy. Spectroscopic techniques are widely used to detect molecules, to measure the fluorescence intensity, solution manual spectroscopy 4th edition 2010

N. Dipesh. "Structural And Optical Investigation Of CdSe(MPA)

Quantum Dots". Kathmandu University Journal Of Science

Engineering And Technology Vol. 8: No. Ii: Dec: 2012: Pp 83-88

P.R.Bueno, C.Santos, G.Belmonte, "Nature of the Schottky-type barrier of highly dense SnO2 systems displaying nonohmic behavior", Journal of Applied Physics 88, 6545-6548 (2000).

P. Yu, et al., "Absorption Cross-Section and Related Optical **Properties of Colloidal InAs Quantum Dots**." Journal of Physical Chemistry B, 2005. 109: p. 7084-7087.

Q. Lu<sup>4</sup> G. Shan And Y. Bai "**Synthesis And Characterization Of CdSe(MPA)/Zno Core/Shell Nanocrystals**" International Journal Of Nanosciencevol.54Nos.2 & 3 (2006) 299-306.

S. Herman, 'CdSe(MPA) Quantum Dots Stabilized By Carboxylic-Functionalized Pva: Synthesis And Uv–Vis Spectroscopy

**Characterization'** Materials Chemistry And Physics 125 (2011) 709–717

S. A. Crooker, J. A. Hollingsworth, S. Tretiak, and V. I. Klimov, "Spectrally Resolved Dynamics of Energy Transfer in Quantum Dots Assemblies : Towards Engineered Energy Flow in Articial Materials", Phys.Rev. Lett. 89, 186802 (2002).

Y. Wang, J. P. Lu"Rapid Synthesis Of CdSe (MPA) Nanocrystals In Aqueous Solution At Room Temperature" .Bull. Mater. Sci., Vol. 33, No. 5, October 2010, Pp. 543–546.

V. Perumal ,Devarajan,K. Yong,D. Nataraj,"Molecular conformation dependent emission behavior (blue, red and white light emissions) of all-trans-b-carotene-ZnS quantum dot hybrid nanostructures" J. Mater. Chem., 2012, 22, 18454.

X. Wang, J. Shi, Z. Feng, M. Li and C. Li "Visible emission characteristics from different defects of ZnS nanocrystals" Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 4715–4723.

## Spectral Study of Non-Homogeneous Hetrojunction Emitting White Color Consisting of: FTO / ZnS / CdSe (MPA)

#### Dr. Kaesar Alyamani

Physics department, Faculty of science, Al- Furat University

#### abstract

Multilayers system of Hetrojunction nanostructure was prepared of semiconductors **\***FTO / ZnS / CdSe (MPA) by using multi technique (heat spray – sol-gel). The optical properties of this system were studied in two stages:

First, by studying the absorption spectra of this system by calculating the spectral transitions energy, proposing the energy levels and the wavelengths through analyzing absorption spectra by using the Doppler shape of broadening spectral line by using the Mathcade program. The value of the quantum oscillator corresponding to each spectral transmission was also calculated ,The life-time of the excited state and Einstein's constants in the automatic release and absorption of these transitions. The changes in the life time of the exceton formed with the change in absorption wavelength were also studied.

Second, by studying PL spectra of multi layers system which showed six photovoltaic peaks covering the whole visible range of the electromagnetic spectral spectrum. According to the color mixing base, this system will produce white. The optical fluorine spectroscopy was analyzed using Mathcade. Electronic transitions Approval with its energy account and corresponding quantum oscillator value.

Keywords: PL spectra , quantum dots, cadmium selenium, zinc sulphide,